

УДК 678.01:66.095

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Я. КАБАНОВ, Л. П. СИДОРОВА, академик Викт. И. СПИЦЫН

**РАДИАЦИОННАЯ ИОННАЯ ПРИВИТАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ**

Сведения о радиационной ионной привитой сополимеризации до настоящего времени весьма ограничены. Так в работах (1-3) было показано, что радиационную прививку по ионному механизму можно осуществить в набухших полимерных системах при низкой температуре. Неоднократно предпринимались попытки провести радиационную прививку при комнатной температуре  $\alpha$ -метилстирола, изобутилена и т. д.— мономеров, полимеризующихся только по ионному механизму. Как правило, прививка не превышала долей процента. Можно предполагать, что неудачные попытки осуществления радиационной ионной привитой сополимеризации при комнатной температуре связаны с недостаточным высушиванием мономеров и всей системы.

В ряде работ за последнее время (4-7) было установлено, что при очень глубокой осушке системы радиационная полимеризация некоторых мономеров протекает с высокими радиационно-химическими выходами и инициируется свободными ионами. Нами разработана методика проведения радиационной прививки в условиях глубокой осушки. В качестве мономеров использовались  $\alpha$ -метилстирол, винил-*n*-бутиловый эфир, изобутилен, эпихлоргидрин и винилциклогексан. Прививка проводилась на полиэтилен, тефлон и поливинилхлорид. Особое внимание обращено на тщательное высушивание мономеров.

После обычной очистки и сушки мономеры длительное время выдерживались над активным гидридом кальция. Затем наступал заключительный этап высушивания специально приготовленной окисью бария. Высушивание проводилось последовательно двумя-тремя порциями последней (в течение недели каждой порцией). В качестве высушивающего агента применялся также металлический натрий, над которым мономер выдерживался не менее месяца. Все операции сушки, переконденсации мономера из одной ампулы в другую, облучения проходили в аппаратуре, тщательно высушенной и отренированной в высоком вакууме ( $\leq 10^{-5}$  мм рт. ст.). Полимерные пленки перед прививкой выдерживались несколько дней над пятиокисью фосфора в условиях, исключающих пощадание последнего на материал. Облучение полимерных пленок, погруженных в высушенный мономер, производилось  $\gamma$ -лучами  $\text{Co}^{60}$  при мощности дозы 7-8 рад/сек в условиях комнатной температуры. Общая доза составляла 0,5 Мрад. После облучения пленки вынимались, тщательно промывались подходящим растворителем и высушивались в вакууме до постоянного веса. Процент прививки рассчитывался по отношению к весу исходной пленки.

Экспериментальные результаты показывают, что процент прививки сильно зависит от степени высушивания мономера. Например, прививка  $\alpha$ -метилстирола на полиэтилен высокого давления (пленка толщиной 80—100  $\mu$ ) при высушивании мономера гидридом кальция равна 0,8%, над одной порцией окиси бария 0,9%, а тремя порциями окиси бария уже равна 14,5—15%. Прививка  $\alpha$ -метилстирола на полиэтилен низкого давления (пленка толщиной 100  $\mu$ ) также сильно зависит от степени высушивания и достигает 10% после сушки мономера тремя порциями окиси бария.

Прививка винил-*n*-бутилового эфира на полиэтилен высокого и низкого давления соответственно равен при сушке гидридом кальция  $\leqslant 1$  и 1,3% и достигает 8,2 и 19% после высушивания двумя порциями окиси бария. Использование ориентированного полиэтилена приводит к уменьшению процента прививки. Предварительное облучение мономера над высушивающим агентом (1—3 Мрад) с последующей переконденсацией мономера практически не изменяет величину прививки. Прививка *α*-метилстирола и винил-*n*-бутилового эфира на тefлон происходит в меньшей степени, до она также зависит от степени сушки и достигает для обоих мономеров 4—5% после тщательного высушивания. Изобутилен, высущенный тремя порциями окиси бария, прививается в количестве 1,7—1,8% на полиэтилен высокого и низкого давления, 0,7% на тefлон и  $\sim 3\%$  на поливинилхлорид (пленка толщиной 500 мк).

Радиационно-химический выход привитой сополимеризации составляет  $5 \cdot 10^2$  —  $3 \cdot 10^3$ . Наиболее заметный выход прививки наблюдается только после высушивания мономера двумя-тремя порциями окиси бария или после выдерживания его над металлическим натрием в течение длительного времени, т. е. когда содержание воды в мономере уменьшится до самого минимального значения.

Эпихлоргидрин не удалось привить даже при самом жестком высушивании системы. Следует также отметить, что использование цеолитов (СаА и НАЛ) для высушивания мономеров не приводит к желаемым результатам, так как наблюдается частичная полимеризация на поверхности, и резко ухудшается высушивающее действие цеолита. Таким образом, твердо установлено, что при очень тщательной осушке можно осуществить при комнатной температуре радиационную прививку мономеров, полимеризующихся только по ионному механизму. При еще более тщательном высушивании несомненно удастся увеличить прививку и радиационно-химический выход этого процесса. Интересно отметить, что в подобных условиях не удается провести радиационную прививку винилциклогексана. Указанный мономер полимеризуется по ионнокоординационному механизму. По-видимому, при облучении полимеров не возникает активных центров, которые могут инициировать полимеризацию винилциклогексана.

Характерной особенностью радиационной ионной прививки при комнатной температуре является незначительное образование гомополимера ( $\leqslant 1\%$ ), несмотря на протекание процесса в жидкой фазе. Поэтому высущенный мономер может быть многократно использован. Преобладание процесса прививки над гомополимеризацией мономера объясняется более высокой разницей в выходе инициирующих центров в твердой и жидкой фазах по сравнению с прививкой в условиях радикального механизма.

Институт физической химии  
Академии наук СССР  
Москва

Поступило  
10 XII 1970

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> A. Chapiro, A. M. Jendrychowska — Bonamour, M. Daniel Roussel, C. R., 262C, № 14, 1132 (1966). <sup>2</sup> A. Chapiro, A. M. Jendrychowska — Bonamour, C. R., 265C, 484 (1967). <sup>3</sup> A. M. Jendrychowska — Bonamour, Europ. Polym. J., 4, 627 (1968). <sup>4</sup> K. Ueno, Ff. Williams et al., Trans. Farad. Soc., 63, 1478 (1967). <sup>5</sup> Ff. Williams, Large Radiat. Sources Industr. Process. Proc. Symp., Munich, 1969. <sup>6</sup> R. B. Taylor, Ff. Williams, J. Am. Chem. Soc., 91, 3728 (1969). <sup>7</sup> К. Халси, О. Окамура, Матер. Международн. симпозиума по полимерам 1967 г., М., 1968, стр. 249.